

Title (en)  
NITRIDE BONDING LAYER.

Title (de)  
NITRID-VERBINDUNGSSCHICHT.

Title (fr)  
COUCHE DE LIAISON DE NITRURE.

Publication  
**EP 0177562 A1 19860416 (EN)**

Application  
**EP 85901781 A 19850319**

Priority  
US 59215284 A 19840322

Abstract (en)  
[origin: WO8504519A1] An integrated circuit chip includes a layer of silicon nitride (4-20) deposited above the upper metallization and silicon oxide intermetallic dielectric (4-10), above which a layer of polyimide (4-50) supports a network of electrical leads; the layer of nitride (4-20) extending completely over the silicon oxide (4-10) from the streets (4-200) at the edge of the die to overlap metallic contacts (4-05) connected from the metallization layer to the upper electrical leads.

Abstract (fr)  
Une puce de circuit intégré comporte une couche de nitrure de silicium (4-20) déposée sur le diélectrique intermétallique d'oxyde de silicium et de métallisation supérieur (4-10) sur laquelle une couche de polyimide (4-50) soutient un réseau de conducteurs électriques; la couche de nitrure (4-20) s'étend entièrement sur l'oxyde de silicium (4-10) à partir des voies (4-200) au bord du dé afin de chevaucher les contacts métalliques (4-0,5) connectés de la couche de métallisation aux conducteurs électriques supérieurs.

IPC 1-7  
**H01L 23/30**; H01L 23/50; H01L 21/318; H01L 21/312

IPC 8 full level  
**H01L 21/312** (2006.01); **H01L 21/318** (2006.01); **H01L 23/532** (2006.01)

CPC (source: EP KR)  
**H01L 23/29** (2013.01 - KR); **H01L 23/5329** (2013.01 - EP); **H01L 2924/0002** (2013.01 - EP)

Designated contracting state (EPC)  
DE FR GB NL

DOCDB simple family (publication)  
**WO 8504519 A1 19851010**; EP 0177562 A1 19860416; EP 0177562 A4 19870603; JP S61501537 A 19860724; KR 860700075 A 19860131

DOCDB simple family (application)  
**US 8500454 W 19850319**; EP 85901781 A 19850319; JP 50141885 A 19850319; KR 850700325 A 19851121